### (12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international





(43) Date de la publication internationale 2 juin 2005 (02.06.2005)

PCT

# (10) Numéro de publication internationale WO 2005/050756 A3

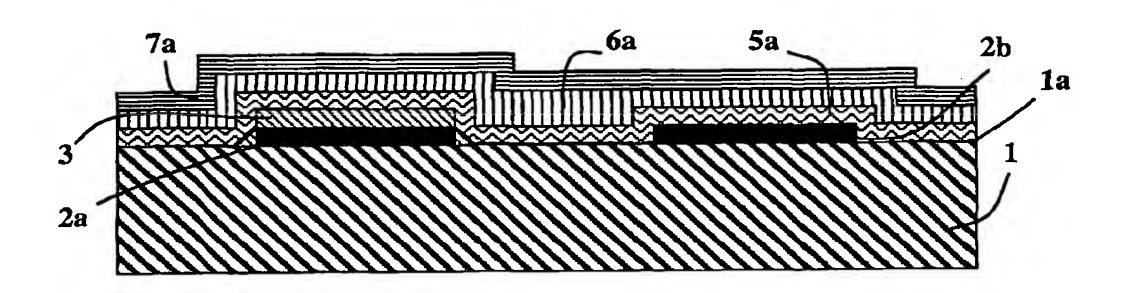
- (51) Classification internationale des brevets<sup>7</sup>:
  HOIM 10/04, 10/36, 2/02, 4/04
- (21) Numéro de la demande internationale : PCT/FR2004/002842
- (22) Date de dépôt international :
  4 novembre 2004 (04.1 1.2004)
- (25) Langue de dépôt : français
- (26) Langue de publication : français
- (30) Données relatives à la priorité :
  0313325 14 novembre 2003 (14.1 1.2003) FR
- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US): COM¬ MISSARIAT A LE NERGIE ATOMIQUE [FR/FR]; 31-33, rue de la Fédération, F-75752 Paris (FR).
- (72) Inventeurs; et
- (75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): GAIL¬LARD, Frédéric [FR/FR]; Rue des Tallifardières, F-38500

Voiron (FR). PLISSONNIER, Marc [FR/FR]; 2, impasse des Camélias, F-38320 Eybens (FR). SALOT, Raphaël [FR/FR]; Lot Verduret, 259, route du Mas, F-38250 Lans en Vercors (FR). ROCHE, Stéphanie [FR/FR]; 58, rue Général Ferrie, F-38100 Grenoble (FR).

- (74) Mandataires: HECKE, Gérard etc.; Cabinet Hecke, WTC Europole, 5, place Robert Schuman, BP 1537, F-38025 Grenoble Cedex 1 (FR).
- (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FT, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW
- (84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,

[Suite sur la page suivante]

- (54) Title: METHOD FOR PRODUCING A LITHIUM MICROBATTERY
- (54) Titre: PROCEDE DE FABRICATION DUNE MICRO-BATTERIE AU LITHIUM



- (57) Abstract: During the production of a lithium microbattery, the electrolyte comprising a lithiated compound is formed by successively depositing an electrolytic thin film (5a), a first protective thin film (6a) that is chemically inert in relation to the lithium, and a first masking thin film (7a) on a substrate (1) provided with current collectors (2a, 2b) and a cathode (3). According to the invention, a photolithography step is carried out on the first masking thin film in order to create a mask for selectively etching the first masking thin layer (7a), and the first protective thin layer (6a) and the electrolytic thin film (5a) are then selectively etched in such a way as to form the electrolyte in the electrolytic thin film (5a). This technique enables the electrolyte to be formed by photolithography and etching without causing any damage thereto.
- (57) Abrégé: Lors de la fabrication d'une micro-batterie au lithium, l'électrolyte comportant un composé lithié est formé en déposant successivement, sur un substrat (1) muni de collecteurs de courant (2a, 2b) et d'une cathode (3), une couche mince électrolytique (5a), une première couche mince de protection (6a) chimiquement inerte par rapport au lithium et une première couche mince de masquage (7a). Une étape de photolithographie sur la première couche mince de masquage permet de réaliser un masque destiné à réaliser une gravure sélective de la première couche mince de protection (6a) et de la couche mince électrolytique (5a) est réalisée de manière à former, dans la couche mince électrolytique (5a), l'électrolyte. Cette technique permet de réaliser l'électrolyte par photolithographie et par gravure sans l'endommager.



## WO 2005/050756 A3



GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Publiée:

- avec rapport de recherche internationale
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

## (88) Date de publication du rapport de recherche internationale: 26 janvier 2006

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abrévialions, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.